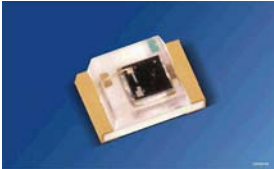


Silicon NPN Phototransistor with  $V_{\lambda}$  Characteristics  
NPN-Silizium-Fototransistor mit  $V_{\lambda}$ -Charakteristik  
Version 1.0

SFH 3710



Features:

- **Spectral range of sensitivity:** 350 ... 950 nm
- **Special:** Adapted to human eye sensitivity ( $V_{\lambda}$ )
- Very small SMT package

Applications

- For control and drive circuits
- Ambient light detector
- Exposure meter for daylight and artificial light
- Sensor for backlight-dimming

Besondere Merkmale:

- **Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit:** 350 ... 950 nm
- **Besonderheit:** Angepasst an die Augenempfindlichkeit ( $V_{\lambda}$ )
- Sehr kleines SMT Gehäuse

Anwendungen

- Messen / Steuern / Regeln
- Umgebungslichtsensor
- Beleuchtungssensor
- Dimmungssensor für Hintergrundbeleuchtung

Ordering Information

Bestellinformation

| Type:<br>Typ: | Photocurrent<br>Fotostrom<br>$\lambda = 560 \text{ nm}$ , $E_e = 10 \text{ } \mu\text{W}/\text{cm}^2$ , $V_{CE} = 5 \text{ V}$<br>$I_{PCE} [\mu\text{A}]$ | Ordering Code<br>Bestellnummer |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SFH 3710      | 2.5 ... 12.5                                                                                                                                              | Q65110A3107                    |
| SFH 3710-2/3  | 2.5 ... 8                                                                                                                                                 | Q65110A3512                    |
| SFH 3710-3/4  | 4 ... 12.5                                                                                                                                                | Q65110A3511                    |

Note: Single bins on request

Anm.: Einzelgruppen auf Anfrage

**Maximum Ratings** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Grenzwerte**

| Parameter<br>Bezeichnung                                                 | Symbol<br>Symbol  | Values<br>Werte | Unit<br>Einheit |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Operating and storage temperature range<br>Betriebs- und Lagertemperatur | $T_{op}; T_{stg}$ | -40 ... 85      | °C              |
| Collector-emitter voltage<br>Kollektor-Emitter-Spannung                  | $V_{CE}$          | 5.5             | V               |
| Collector current<br>Kollektorstrom                                      | $I_C$             | 20              | mA              |
| Emitter-collector voltage<br>Emitter-Kollektor-Spannung                  | $V_{EC}$          | 0.5             | V               |

**Characteristics** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Kennwerte**

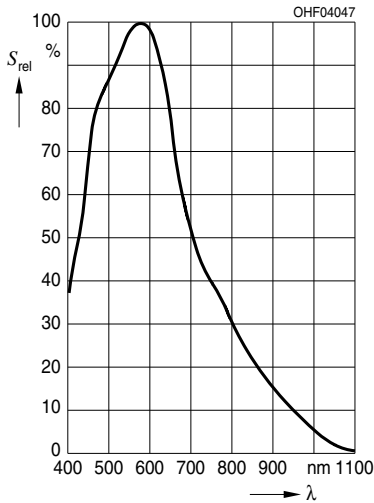
| Parameter<br>Bezeichnung                                                             | Symbol<br>Symbol         | Values<br>Werte | Unit<br>Einheit |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Wavelength of max. sensitivity<br>Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit           | $\lambda_{S\text{ max}}$ | 570             | nm              |
| Spectral range of sensitivity<br>Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit          | $\lambda_{10\%}$         | 350 ... 950     | nm              |
| Radiant sensitive area<br>Bestrahlungsempfindliche Fläche                            | A                        | 0.29            | mm <sup>2</sup> |
| Dimensions of chip area<br>Abmessung der Chipfläche                                  | L x W                    | 0.75 x 0.75     | mm x mm         |
| Half angle<br>Halbwinkel                                                             | $\phi$                   | ± 60            | °               |
| Capacitance<br>Kapazität<br>( $V_{CE} = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$ , $E = 0$ ) | $C_{CE}$                 | 4               | pF              |
| Dark current<br>Dunkelstrom<br>( $V_{CE} = 5\text{ V}$ , $E = 0$ )                   | $I_{CE0}$                | 3 ( $\leq 50$ ) | nA              |
| Temperature coefficient<br>Temperaturkoeffizient<br>(Std. Light A)                   | TC                       | 0.9             | % / K           |
| Temperature coefficient<br>Temperaturkoeffizient<br>( $\lambda = 550\text{ nm}$ )    | TC                       | 0.78            | % / K           |

Grouping ( $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $\lambda = 560\text{ nm}$ )  
Gruppierung

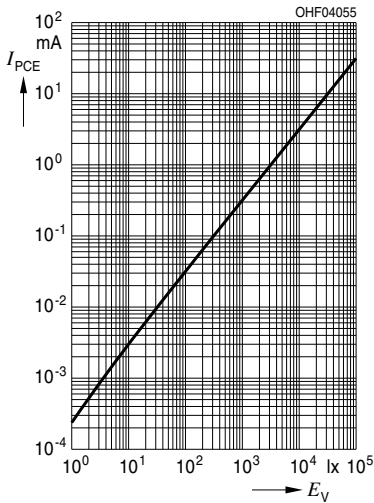
| Group      | Min Photocurrent                                                                                                   | Max Photocurrent                                                                                                   | Typ Photocurrent                                                                             | Collector-emitter saturation voltage                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gruppe     | Min Fotostrom                                                                                                      | Max Fotostrom                                                                                                      | Typ Fotostrom                                                                                | Kollektor-Emitter Sättigungsspannung                                                                           |
|            | $E_e = 10\text{ }\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ,<br>$V_{CE} = 5\text{ V}$<br>$I_{PCE, \text{min}}\text{ }[\mu\text{A}]$ | $E_e = 10\text{ }\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ,<br>$V_{CE} = 5\text{ V}$<br>$I_{PCE, \text{max}}\text{ }[\mu\text{A}]$ | $E_v = 1000\text{ lx, Std. Light A, } V_{CE} = 5\text{ V}$<br>$I_{PCE}\text{ }[\mu\text{A}]$ | $I_C = I_{PCEmin} \times 0.3$ ,<br>$E_e = 10\text{ }\mu\text{W}/\text{cm}^2$<br>$V_{CEsat}\text{ }[\text{mV}]$ |
| SFH 3710-2 | 2.5                                                                                                                | 5                                                                                                                  | 220                                                                                          | 100                                                                                                            |
| SFH 3710-3 | 4                                                                                                                  | 8                                                                                                                  | 350                                                                                          | 100                                                                                                            |
| SFH 3710-4 | 6.3                                                                                                                | 12.5                                                                                                               | 570                                                                                          | 100                                                                                                            |

Note.:  $I_{PCEmin}$  is the min. photocurrent of the specified group  
Anm.:  $I_{PCEmin}$  ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe

Relative Spectral Sensitivity  
Relative spektrale Empfindlichkeit  
 $S_{rel} = f(\lambda)$

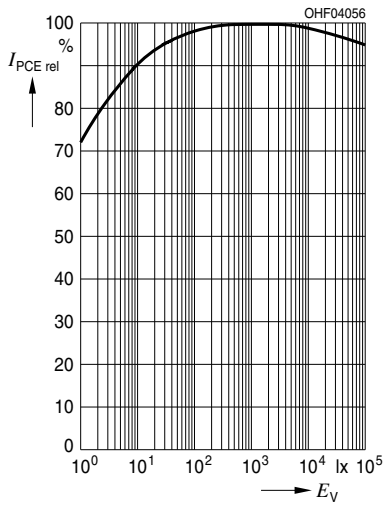


Photocurrent  
Fotostrom  
 $I_{PCE} = f(E_v)$



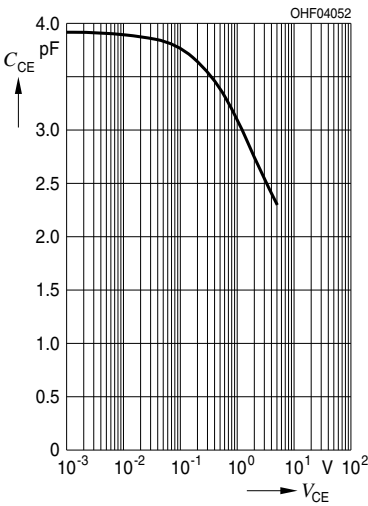
**Photocurrent  
Fotostrom**

$I_{PCE} = f(E_V)$



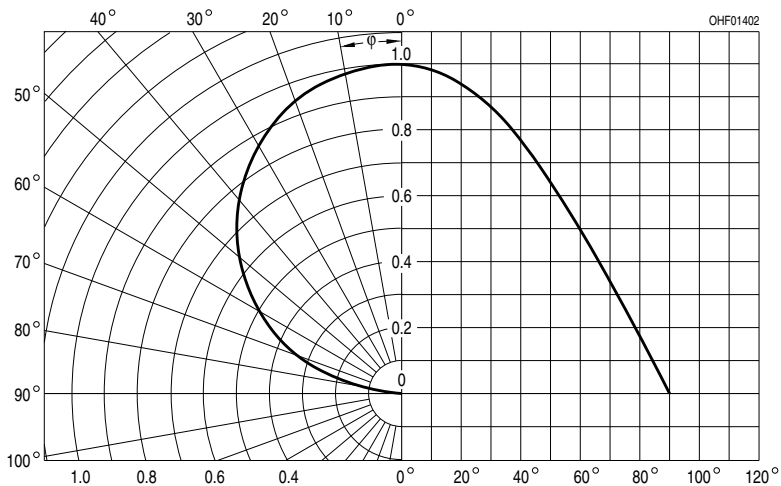
**Collector-Emitter Capacitance  
Kollektor-Emitter Kapazität**

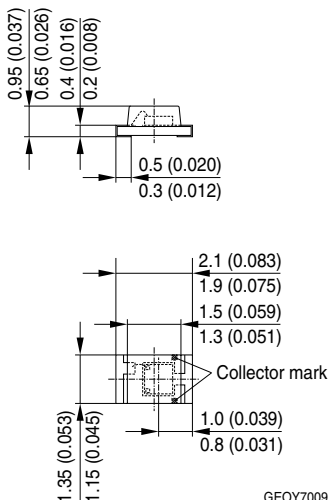
$C_{CE} = f(V_{CE}), f = 1\ MHz, E = 0$



**Directional Characteristics  
Winkeldiagramm**

$S_{rel} = f(\varphi)$

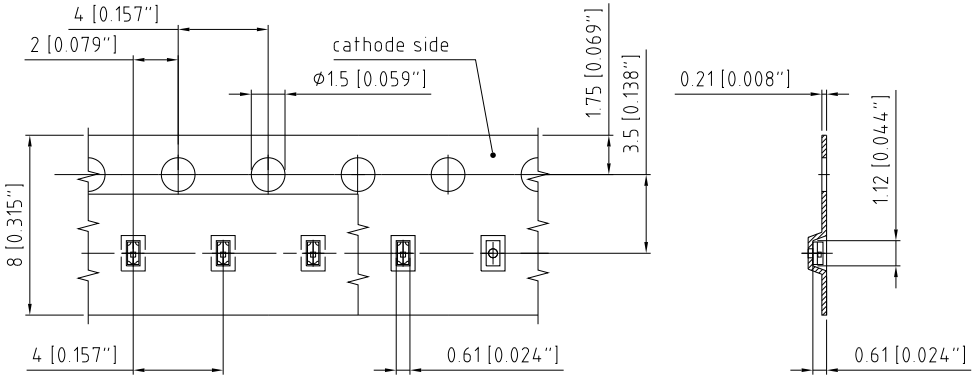


**Package Outline**  
**Maßzeichnung**

GEOY7009

*Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).*

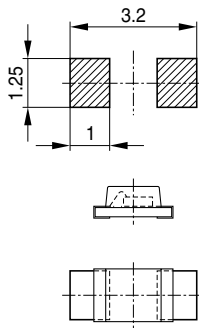
**Method of Taping**  
**Gürtung**



C63062-A4.114-B1-02

Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

**Recommended Solder Pad**  
**Empfohlenes Lötpad design**



Bauteil positioniert  
Component location on pad

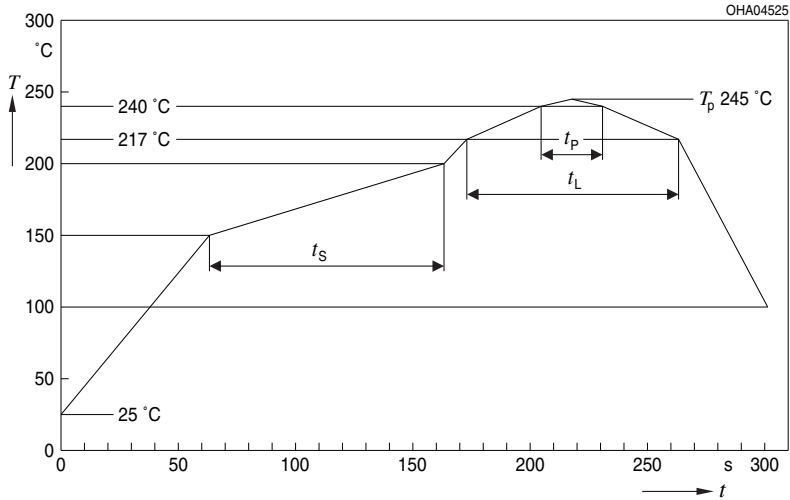
OHFP2578

Dimensions in mm. / Maße in mm.

# Reflow Soldering Profile

## Reflow-Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



OHA04612

| Profile Feature<br>Profil-Charakteristik                          | Symbol<br>Symbol | Pb-Free (SnAgCu) Assembly |                |         | Unit<br>Einheit |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------|-----------------|
|                                                                   |                  | Minimum                   | Recommendation | Maximum |                 |
| Ramp-up rate to preheat*)<br>25 °C to 150 °C                      |                  |                           | 2              | 3       | K/s             |
| Time $t_s$<br>$T_{Smin}$ to $T_{Smax}$                            | $t_s$            | 60                        | 100            | 120     | s               |
| Ramp-up rate to peak*)<br>$T_{Smax}$ to $T_p$                     |                  |                           | 2              | 3       | K/s             |
| Liquidus temperature                                              | $T_L$            | 217                       |                |         | °C              |
| Time above liquidus temperature                                   | $t_L$            |                           | 80             | 100     | s               |
| Peak temperature                                                  | $T_p$            |                           | 245            | 260     | °C              |
| Time within 5 °C of the specified peak<br>temperature $T_p$ - 5 K | $t_p$            | 10                        | 20             | 30      | s               |
| Ramp-down rate*)<br>$T_p$ to 100 °C                               |                  |                           | 3              | 6       | K/s             |
| Time<br>25 °C to $T_p$                                            |                  |                           |                | 480     | s               |

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

\*) slope calculation  $DT/Dt$ :  $Dt$  max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

**Disclaimer****Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!**

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

\*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

\*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

**Disclaimer****Bitte beachten!**

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

**Verpackung**

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

**Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!**

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen\*\* nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

\*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

\*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH  
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg  
[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com) © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。